

# 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ

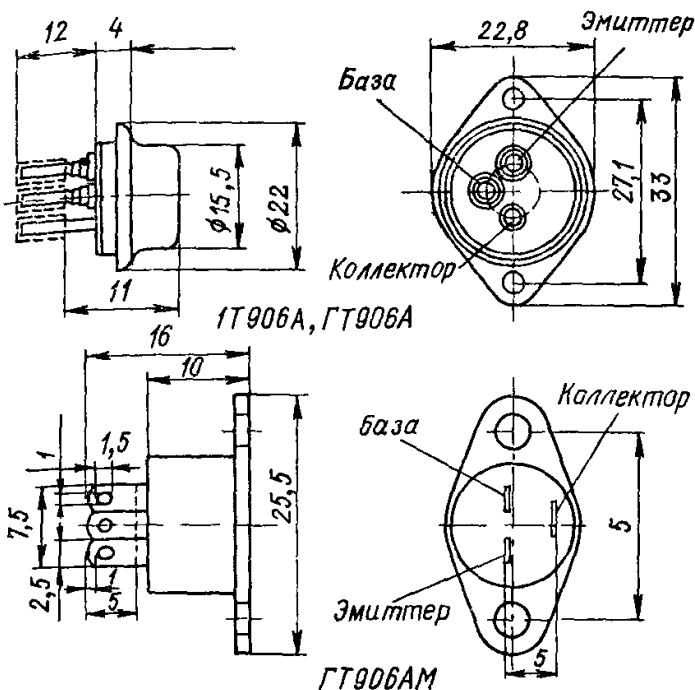
Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные *p-n-p* переключательные мощные

Предназначены для применения в преобразователях напряжения, переключающих и других импульсных каскадах радиоэлектронных устройств

Выпускаются в металлостеклянном (1Т906А, ГТ906А) и металлопластмассовом (ГТ906АМ) корпусах с жесткими выводами

Обозначение типа приводится на корпусе

Масса транзистора в металлостеклянном корпусе не более 4,5 г (с крепежным фланцем не более 6 г), в металлопластмассовом корпусе не более 7 г.



## Электрические параметры

Граничное напряжение при  $I_{Эн} = 5$  А не менее

1Т906А . . . . .	65 В
ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	75 В

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_{Э} = 0,5$ А 1Т906А не менее . . . . .	30 МГц
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{К} = 5$ А, $I_{Б} = 0,5$ А не более 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ при $T = 298$ К . . . . .	0,5 В
1Т906А при $T = 213$ К . . . . .	0,5 В
при $T = 343$ К . . . . .	1,0 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_{К} = 5,0$ В, $I_{Б} = 0,5$ А не более 1Т906А . . . . .	0,6 В
ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	0,7 В
Время включения при $U_{КБ} = 30$ В, $I_{Б и} = 0,5$ В, $\tau_{и} = 20$ мкс, $f = 50$ Гц не более . . . . .	1,0 мкс
Время рассасывания при $U_{КБ} = 30$ В, $I_{Б и} = 0,5$ В, $\tau_{и} = 20$ мкс, $f = 50$ Гц не более . . . . .	5,0 мкс
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_{Э} = 5$ А 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ при $T = 298$ К . . . . .	30–150
1Т906А при $T = 213$ К . . . . .	30–170
при $T = 343$ К . . . . .	20–150
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КБ} = 75$ В, $U_{ЭБ} = 0,5$ В не более: при $T = 298$ К при $T = 213$ К 1Т906А, ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	8,0 мА
при $T = 343$ К: 1Т906А . . . . .	15,0 мА
ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	30,0 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 1,4$ В не более: 1Т906А . . . . .	8,0 мА
ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	15,0 мА

## Предельные эксплуатационные данные

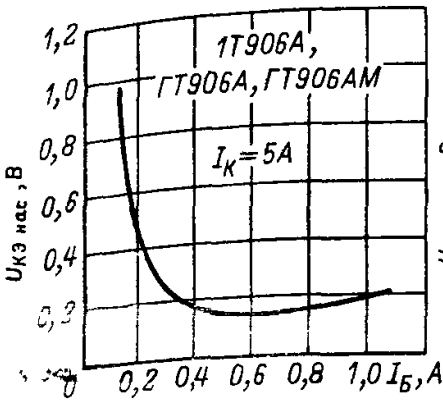
Напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 0,5 \div 1,4$ В	75 В
Импульсное напряжение коллектор-эмиттер запертого транзистора при $\tau_n \leq 20$ мкс и $Q \geq 3$ ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	130 В
Напряжение коллектор-база . . . . .	75 В
Напряжение база-эмиттер . . . . .	1,4 В
Постоянный или импульсный (в режиме переключения) ток коллектора:	
1Т906А . . . . .	5,0 А
ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	6,0 А
Постоянный или импульсный ток коллектора в режиме насыщения при токе выключения 1Т906А не более 5 А и ГТ906А, ГТ906АМ не более 6 А . . . . .	10,0 А
Ток коллектора в режиме переключения 1Т906А при $U_{КЭ} = 36$ В и выбросах напряжения до 45 В, $\tau_n \leq 10$ мкс и $U_{КЭ} \leq 25$ В ГТ906А, ГТ906АМ . . . . .	7,0 А
Постоянный или средний (за период не более 2 мс) ток базы . . . . .	1,5 А
Постоянная или средняя (за период не более 2 мс) рассеиваемая мощность при $T_k \leq 310,5$ К . . . . .	15,0 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность:	
при $\tau_n \leq 10$ мкс . . . . .	375 Вт
при $\tau_n \leq 200$ мкс, $f \leq 5$ Гц и $U_k \leq 60$ В . . . . .	300 Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус . . . . .	2,5 К/Вт
Тепловое сопротивление переход-среда . . . . .	50 К/Вт
Температура перехода . . . . .	348 К
Температура окружающей среды . . . . .	От 213 до $T_k = 343$ К

Примечание. При  $T_k > 310,5$  К максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность, Вт, рассчитывается по формуле

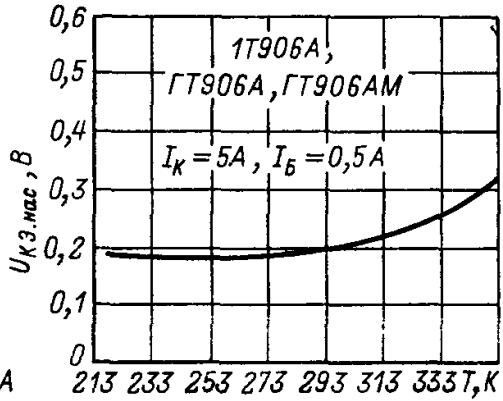
$$P_{K. \max} = (348 - T_k)/2,5.$$

Материал взят из источника:

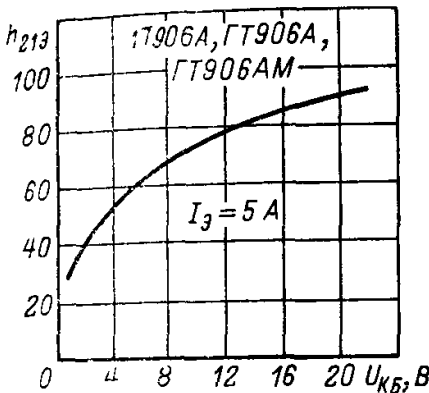
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)  
Энергоатомиздат, 1985



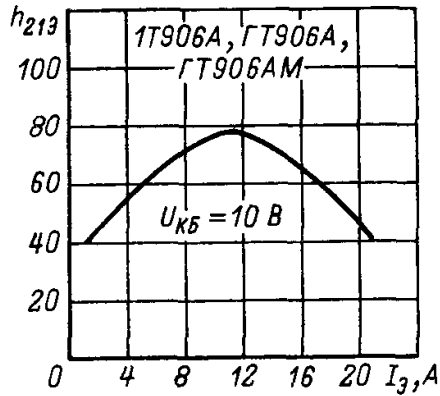
Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от температуры.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор-база.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.

Материал взят из источника: